

SYLABUS
dotyczy cyklu kształcenia 2023/2024–2024/2025
(skrajne daty)
Rok akademicki 2024/2025

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu	Wykład monograficzny
Kod przedmiotu*	
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek	Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nazwa jednostki realizującej przedmiot	Kolegium Nauk Przyrodniczych
Kierunek studiów	Fizyka
Poziom studiów	studia drugiego stopnia, po studiach inż.
Profil	ogólnoakademicki
Forma studiów	studia stacjonarne
Rok i semestr/y studiów	II rok, semestr 3
Rodzaj przedmiotu	przedmiot specjalnościowy: Fizyka medyczna
Język wykładowy	polski
Koordinator	dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących	

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr (nr)	Wykł.	Ćw.	Konw.	Lab.	Sem.	ZP	Prakt.	Projekt	Liczba pkt. ECTS
3	15								2

1.2. Sposób realizacji zajęć

- zajęcia w formie tradycyjnej
 zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Zaliczenie bez oceny

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Student ma wiedzę z zakresu podstaw fizyki, studia I stopnia, obejmującą elektryczność, magnetyzm i optykę falową. Zna podstawowe zagadnienia z mechaniki kwantowej (niezależne od czasu równanie Schrodingera i jego rozwiązania dla zagadnień jednowymiarowych, zagadnienie cząstki w studni potencjału, efekt tunelowy, oscylator harmoniczny). Ma wiedzę

z zakresu podstaw fizyki ciała stałego obejmującą krystalografię, metody dyfrakcji rentgenowskiej, własności fizyczne metali, półprzewodników i dielektryków, model pasmowy ciał stałych, przejścia optyczne w półprzewodnikach. Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne wytwarzania cienkich warstw (MBE, PLD, CVD, MOCVD).

3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu

C ₁	nabycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat roli i znaczenia materiałów azotkowych w elektronice wysokich częstotliwości, temperatur i mocy oraz roli i znaczenia wybranych nanomateriałów na bazie diamentu w zastosowaniach medycznych
C ₂	zaznajomienie z własnościami fizycznymi, mechanicznymi i termicznymi wybranych półprzewodników szerokopasmowych
C ₃	zaznajomienie z podstawowymi metodami hodowania masywnych kryształów azotkowych oraz technikami epitaksjalnymi wytwarzania cienkich warstw
C ₄	zaznajomienie z podstawowymi technikami wytwarzania nanodiamentów
C ₅	nabycie wiedzy na temat detektorów w zakresie dalekiego ultrafioletu
C ₆	zapoznanie z rozwojem i perspektywami diod LED emitujących w zakresie UV
C ₇	zapoznanie z wybranymi aspektami teorii funkcjonałów gęstości elektronowej
C ₈	wykształcenie umiejętności intuicyjnego rozumienia omawianych zjawisk fizycznych i posługiwania się poprawną terminologią fizyczną
C ₉	zdobycie wiedzy umożliwiającej prowadzenie badań naukowych w zakresie wybranych zagadnień fizyki fazy skondensowanej

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

EK (efekt uczenia się)	Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu	Odniesienie do efektów kierunkowych ¹
EK_01	Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące własności fizycznych, mechanicznych i termicznych wybranych półprzewodników szerokopasmowych (SiC, GaN, AlN, InN, BN) oraz nanodiamentu, znaczenia tych materiałów dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności dla rozwoju elektroniki wysokich częstotliwości, temperatur i mocy, efektywnego przetwarzania energii oraz dla rozwoju nanomedycyny.	K_Wo1

¹ W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

EK_o2	Student zna i rozumie techniki doświadczalne, w szczególności wybrane metody wytwarzania objętościowych i epitaksjalnych materiałów azotkowych oraz węgla krzemu: krystalizację w wysokim ciśnieniu, HVPE, ammonotermalną, sublimacyjno – kondensacyjną, PVT oraz LPE i CVD. Zna wybrane metody syntezy nanodiamentów: syntezy detonacyjnej, pod wysokim ciśnieniem i temperaturą (HPHT), mielenia kulowego mikrokryształów HPHT i ablacji laserowej.	K_Wo3
EK_o3	Student zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie fizyki materiałów azotkowych, w szczególności zna sposoby polepszania zewnętrznej wydajności kwantowej i mocy azotkowych diod LED operujących w zakresie DUV. Zna obecny stan zaawansowania i orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych z zakresu materiałów funkcjonalnych i nanotechnologii oraz zna obszary ich zastosowania	K_Wo6
EK_o4	Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnego rozwoju fizyki, dotyczące nanomedycyny	K_Wo7
EK_o5	Student zna i rozumie uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością naukową fizyka	K_Wo8
EK_o6	Student potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej dostępnej w sieci uczelnianej UR, bazach danych i innych źródłach	K_Uo3
EK_o7	Student potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim na temat roli i znaczenia materiałów azotkowych w elektronice wysokich częstotliwości, temperatur i mocy oraz nanodiamentów w rozwoju nanomedycyny	K_Uo5
EK_o8	Student potrafi komunikować się z odbiorców o różnym stopniu wykształcenia oraz prowadzić debatę przedstawiając i oceniając prezentowane opinie	K_Uo7
EK_o9	Student potrafi określić kierunki dalszego samokształcenia pod kątem wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych w optoelektronice i mikroelektronice wysokich częstotliwości, temperatur i mocy i jest w stanie wskazuje drogę rozwoju innym studentom	K_Uo9
EK_o10	Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi w zakresie fizyki ciała stałego jak i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz rozwijania dorobku zawodowego	K_Ko6

3.3 Treści programowe

A. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne

1. Półprzewodniki – podstawowe cechy, własności i ich reprezentanci. Struktury pasmowe, materiały prosto- i skośnopasmowe, przejścia optyczne – przypomnienie.
2. Rozwój materiałów funkcjonalnych i obszary ich zastosowania. Rola półprzewodników w elektronice wysokich temperatur, mocy i częstotliwości. Ograniczenia technologii krzemowej w elektronice (MOSFET, HEMT). Materiały nowej generacji SiC, GaN, AlN, InN, BN dla urządzeń wysokich mocy, częstotliwości i temperatur.
3. Struktura i politypy SiC. Własności fizyczne węgla krzemu. Stabilność termiczna politypów SiC. Podstawowe metody wzrostu objętościowych kryształów SiC: PVT, CVD. Efekt polarności zarodka na wzrost preferowanego politypu. Homepitaksja na stopniach metodą CVD.
4. Struktura i politypizm azotku galu GaN, własności fizyczne, przyczyny wbudowanego makroskopowego pola elektrycznego. Wzrost GaN na podłożu i związane z nim problemy; wczesne próby wzrostu – wzrost heteroepitaksjalny MBE na podłożu szafirowym z warstwami buforowymi. Niedopasowanie sieciowe. Najważniejsze metody wzrostu GaN: krystalizacja w wysokim ciśnieniu, HVPE, amonotermalna, PA-MBE, MOCVD – wady i zalety. Domieszkowanie, defekty. Nagroda Nobla z fizyki z 2014r. *"for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources"*. Uwarunkowania prawne i etyczne działalności naukowej fizyków na przykładzie losów polskiej spółki Ammono.
5. Struktura krystaliczna, właściwości AlN. Metody wytwarzania objętościowych kryształów AlN: metoda sublimacyjno-kondensacyjna z zarodkiem, PVT, HVPE. Wpływ formacji międzypowierzchni na jakość strukturalną AlN w metodzie sublimacyjnej. Wzrost epitaksjalny warstw AlN na podłożu szafirowym z warstwą buforową AlN (metoda LPE).
6. Azotki jako fotodetektory dalekiego ultrafioletu (DUV). Struktura epitaksjalnej diody elektroluminescencyjnej. Detektory UV z azotku glinu – zastosowania, AlN-SiC jako fotodetektor DUV w oparciu o hybrydową barierę Schottkiego. Parametry fotodetektora. Inne azotki dla urządzeń DUV. Struktura emitera DUV ze studniami kwantowymi $Al_xGa_{1-x}N$. Nowe podejścia dla polepszenia zewnętrznej wydajności kwantowej EQE oraz mocy P emitera. Problem niskiego przewodnictwa warstwy p- $Al_xGa_{1-x}N$.
7. Nanodiamenty w nanomedycynie. Synteza (metoda kontrolowanej detonacji, synteza w warunkach wysokich ciśnień i temperatury HPHT, mielenie kulowe kryształów HPHT, ablacji laserowej). Własności nanodiamentów i ich zastosowanie w bioobrazowaniu, bioznakowaniu, biosensorach, terapii celowanej, termoterapii.

8. DFT– teoria funkcjonału gęstości elektronowej – zastosowanie do modelowania wzrostu warstw.

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu	Metody oceny efektów uczenia się (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)	Forma zajęć dydaktycznych (w., ćw., ...)
EK_01	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja, referat	wykład
EK_02	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja, referat	wykład
EK_03	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja, referat	wykład
EK_04	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja	wykład
EK_05	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja	wykład
EK_06	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja, referat	wykład
EK_07	dyskusja, referat	wykład
EK_08	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja	wykład
EK_09	dyskusja	wykład
EK_10	obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja, referat	wykład

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie aktywnego uczestnictwa w dyskusji oraz sporządzenia pisemnego referatu z wybranego zagadnienia omawianego podczas wykładów. Wykład monograficzny zaliczany jest bez oceny (zal.).

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny z harmonogramu studiów	15
Inne z udziałem nauczyciela akademickiego (udział w konsultacjach, egzaminie)	2
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)	33
SUMA GODZIN	50
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	2

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy	n.d.
zasady i formy odbywania praktyk	n.d.

7. LITERATURA

Literatura podstawowa: <ol style="list-style-type: none">1. Andrzej Oleś, <i>Metody doświadczalne fizyki ciała stałego</i>, Warszawa, WNT, 19982. H. Ibach, H. Lüth, <i>Fizyka ciała stałego</i>, PWN, Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca: <p>Artykuły w wybranych czasopismach naukowych dostępnych w sieci uczelnianej Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Biblioteki UR:</p> <ol style="list-style-type: none">1. B Jayant Baliga, <i>Gallium nitride devices for power electronic applications</i> <i>Semicond. Sci. Technol.</i> 28 (2013) 074011 (8pp)2. Srabanti Chowdhury, Brian L Swenson, Man Hoi Wong and Umesh K Mishra, <i>Current status and scope of gallium nitride-based vertical transistors for high-power electronics application</i>, <i>Semicond. Sci. Technol.</i> 28 (2013) 0740143. F. Bechstedt, P. Kaeckell, A. Zywietz, K. Karch, B. Adolph, K. Tenelsen, and J. Furthmueller, <i>Polytypism and Properties of Silicon Carbide</i>, <i>Physica Status Solidi B</i>, 202, 35 (1997).4. G. Augustine, H. McD. Hobgood, V. Balakrishna, G. Dunne, and R. H. Hopkins, <i>Physical Vapor Transport Growth and Properties of SiC Monocrystals of 4H Polytype</i>, <i>Physica Status Solidi B</i>, 202, 137 (1997)5. T. Kimoto, A. Itoh, and H. Matsunami, <i>Step-Controlled Epitaxial Growth of High-Quality SiC Layers</i>, <i>Physica Status Solidi B</i>, 202, 247 (1997)6. P. Kung and M. Razghi, <i>III-Nitride wide bandgap semiconductors: a survey of a current status of the material and device technology</i>, <i>Opto-Electronics Review</i>, 8, 201-239 (2000)7. R. Dwiliński, R. Doradziński, J. Garczyński et al., <i>Excellent crystallinity of truly bulk ammonothermal GaN</i>, <i>Journal of Crystal Growth</i> 310 (2008) 3911– 39168. Dirk Ehretraut, Yuji Kagamitani, Tsuguo Fukuda et al., <i>Reviewing recent developments in the acid ammonothermal crystal growth of gallium nitride</i>, <i>Journal of Crystal Growth</i> 310 (2008) 3902– 39069. Mariusz Rudziński, Marek Wesołowski, Włodzimierz Strupiński, <i>Niebieskie, zielone i białe emitory światła wytwarzane z półprzewodników A^{III}-B^N</i>, <i>Przegląd Elektrotechniczny</i>, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 7/201410. Hiroyuki Fukuyama and Shin-ya Kusunoki, Akira Hakomori, Kenji Hiraga, <i>Single crystalline aluminum nitride films fabricated by nitriding α-Al₂O₃</i>, <i>Journal of Applied Physics</i>, 100, 024905 (2006)

11. Hiroyuki Kamata, Yuu Ishii, Toshiaki Mabuchi, Kunihiro Naoe et al., *Single Crystal Growth of Aluminum Nitride*, Fujikura Technical Review, p. 41-45, 2009 (http://www.fujikura.co.jp/eng/rd/gihou/backnumber/pages/_icsFiles/afieldfile/2009/06/04/38e_09.pdf)
12. D. Zhuang, Z.G. Herro, R. Schlessler, Z. Sitar, *Seeded growth of AlN single crystals by physical vapor transport*, Journal of Crystal Growth **287** (2006) 372–375
13. M. Leszczynski, H. Teisseyre, T. Suski, I. Grzegory, M. Bockowski, J. Jun, S. Porowski, K. Pakula, J. M. Baranowski, C. T. Foxon, T.S. Cheng, *Lattice parameters of gallium nitride*, Appl. Phys. Lett. **69**(1) (1996), 73-75
14. Journal of Crystal Growth Volume **310**, Issue 17, Pages 3901-4026 (15 August 2008): Special issue IWBNS-5, International Workshop on Bulk Nitride Semiconductors V (<http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220248/310/17>)
15. Adachi Masayoshi; Maeda Kazuo; Tanaka Akikazu et al., *Homoepitaxial growth of AlN on nitrated sapphire by LPE method using Ga-Al binary solution*, Phys. Status Solidi A **208**, No. 7, 1494–1497 (2011)
16. R. Dahal, T. M. Al Tahtamouni, Z. Y. Fan et al., *Hybrid AlN–SiC deep ultraviolet Schottky barrier photodetectors*, Appl. Phys. Lett. **90**, 263505 (2007)
17. Yoshihiko Muramoto, Masahiro Kimura and Suguru Nouda, *Development and future of ultraviolet light-emitting diodes: UV-LED will replace the UV lamp*, Semiconductor Science and Technology, **29**, 084004 (2014) (<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0268-1242/29/8/084004/meta>)
18. H X Jiang and J Y Lin, *Hexagonal boron nitride for deep ultraviolet photonic devices*, Semicond. Sci. Technol. **29**, 084003 (2014)
19. Wykład noblowski Shuji Nakamury z 2014r: (https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/nakamura-lecture.pdf)
20. M. Sznajder, E. Wachowicz, and J.A. Majewski, *Ab initio studies of early stages of nitride growth process on silicon carbide* - Journal of Crystal Growth, **401**, 25-29 (2014).
21. M. Grabowski, M. Sznajder, J.A. Majewski, *Morphology and Stability of the C/BN Interfaces: Ab Initio Studies*, Acta Phys. Pol. **129**, A138-A141 (2016).
22. M. Sznajder, R. Hrytsak, *Ab initio studies of early stages of AlN growth process on the oxygen terminated diamond (111) surface*, Diamond & Related Materials **83**, 94–103 (2018)
23. M. Sznajder, *DFT-based modelling of carbon adsorption on the AlN surfaces and influence of point defect on the stability of diamond/AlN interfaces*, Diamond & Related Materials **103**, 107694, 10pp (2020)
24. M. Sznajder, R. Hrytsak, *DFT-Based Studies on Carbon Adsorption on the wz-GaN Surfaces and the Influence of Point Defects on the Stability of the Diamond–GaN Interfaces*, Materials **14**(21):6532

25. Jin-Xu Qin et al., *Nanodiamonds: Synthesis, properties, and applications in nanomedicine*, *Materials & Design* **210** (2021) 110091
26. Swati Chauhan et al., *Nanodiamonds with powerful ability for drug delivery and biomedical applications: Recent updates on in vivo study and patents*, *Journal of Pharmaceutical Analysis* **10** (2020) 1-12
27. Weina Liu et al., *Silicon-Vacancy Nanodiamonds as High Performance Near-Infrared Emitters for Live-Cell Dual-Color Imaging and Thermometry*, *Nano Lett.* 2022, **22**, 2881–2888
28. V. Benson et al., *Why nanodiamond carriers manage to overcome drug resistance in cancer*, *Cancer Drug Resist* 2020; **3**:854-66
29. C. Fryer et al., *Evaluation of Cytotoxicity and Bioimaging of Nitrogen-Vacancy Nanodiamonds*, *Nanomaterials* 2022, **12**, 4196.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej